硫酸锂钠非线性光学晶体及其制备方法和用途

潘世烈[1]; 韩国鹏; 王颖

2018-03-06

专利权人 中国科学院新疆理化技术研究所

专利类型 发明专利

摘要 本发明涉及一种硫酸锂钠非线性光学晶体及其制备方法和用途。该晶体的分子式为$LiNaSO_4$，分子量为125.986，属于三方晶系，空间群为P31c，晶胞参数为：a=7.6004(4) Å，b=7.6004(4) Å,c=9.827(10) Å，V=491.5(6) $Å^3$，采用提拉高温法生长晶体。该晶体的非线性光学效应约为KH$_2$PO$_4$(KDP)的3倍，光学带隙宽度为7.09eV，紫外截止边为175 nm，对（深）紫外、可见及近红外波段具有较宽的通过率，适合制作非线性光学器件。

申请日期 2016-08-16

申请号 CN201610675515.0

公开（公告）号 CN107761170A

代理机构 乌鲁木齐中科新兴专利事务所 65106

文献类型 专利

条目标识符 http://ir.tianshanzv.cn/handle/365002/6588

专题 材料物理与化学研究室

推荐引用方式 GB/T 7714 潘世烈,韩国鹏,王颖. 硫酸锂钠非线性光学晶体及其制备方法和用途. CN107761170A[P]. 2018-03-06.

条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0) [发表评论/异议/意见]

暂无评论

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

版权所有 @2018 - 2024 中国科学院新疆理化技术研究所 - Powered by CSpace

地址邮编 新疆乌鲁木齐市北京南路40-1号（830011） 电话: 0991-3838931